

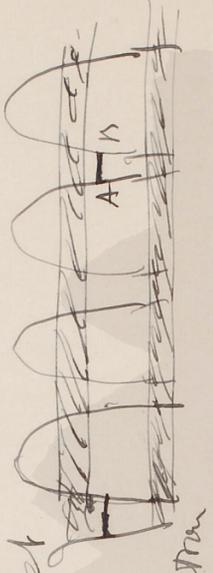
之 + 特殊力 + ... 湯川秀樹史料 (中間子論関係)
 semiconductor ... ion, electron ...
 ... Elektronenleiter ...
 metal or semi-metal ...
 = impurity ... resistance ...
 ... temperature coeff.
 ... substance & semiconductor
 (Titanium ... superconductor ...)
 ... semi-conductor ...
 ... insulator ...
 ... electronic semi-conductor ...
 ... pure ... metallic
 ... impure ...
 ... negative temp. coef. ...
 ... (Frenkel Phys. Rev. 36 p. 1804) (1930)
 ... cuprous oxide ... negative
 temp coef ... pure ... conductivity ...
 ...
 ... germanium ...
 ... modification ... metallic ...
 insulating ...

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

CuO (cuprous oxide) は $\sigma = 0.0$ の導電率を示す。Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。



以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

以上、一般に導電率を算出するに、Vogt, 最後 $\sigma = \frac{W_2 - W_1}{2KT} e$ の式を用いる。

photoeffect, ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 不純物 impure, 不純度 impurity 不純度 ρ 抵抗率 conductivity 導電率 σ

Vogt, 2007 Hall coef. \dots
 $eR = 10^{-18} \text{ } \int_{19.00/T}$

classically \dots
 cubic centimeter = 10^{18} atoms, impurity, atom $\rho = 10^{-18}$
 図 3, 式 5 $eR = 10^{-16} T^{-3/4} e^{39.00/T}$

$$\therefore \sqrt{\frac{N_0}{Ga^3}} = \frac{3}{4} \pi^{1/4} a^{3/4} 10^{16} \left(\frac{a}{\text{Å}}\right)^{3/4}$$

$a^3 \approx 10^{-22}$, $\rho = 1 \text{ volt}$, $N_0/Ga^3 = 10^{19}$
 cubic centimeter $\rho = 10^{19}$ atoms, $\rho = 10^{19}$ molecules, 10^{22}

ρ is \rightarrow conductivity of impurity to ρ atoms
 intrinsic ρ to ρ atoms, N_0 , ρ atoms ρ atoms
 (intrinsic ρ to ρ atoms, N_0 , ρ atoms ρ atoms)

2.2.1. 自由電子の分布 ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 自由電子 (Vogt, 式 7) $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 free electron, ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 arrangement ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity
 ρ 抵抗率 $\rho = 1/\sigma$ 導電率 σ 導電率 conductivity

CD band 1, top of F val. current in - $\text{B}_2 + \text{B}_2$
(subphor) "hole", particular atom - attach L_2 to L_2

子 L_2 の al. L_2 の, L_2 の essential L_2 の

At, CD, L_2 の L_2 の

(inochrome, L_2 の photoel, curve + absorp, curve
- L_2 の L_2 の L_2 の absorption L_2 の

excite L_2 の atom, L_2 の L_2 の. L_2 の L_2 の, perfect lattice

= in state, band L_2 の, classif. L_2 の L_2 の, individual

atom = L_2 の classif. L_2 の L_2 の L_2 の L_2 の L_2 の

L_2 の L_2 の L_2 の

